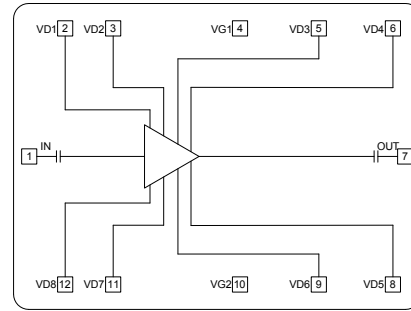


特点:

- 频率: 32~36GHz
- 增益: 23dB
- 输出 P-1dB: +32dBm
- 工作电压电流: +6V@1000mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 3.25×1.8×0.1mm

功能框图



性能参数: (TA=+25℃, VD=+6V, VG=-0.35V, ID=1000mA)

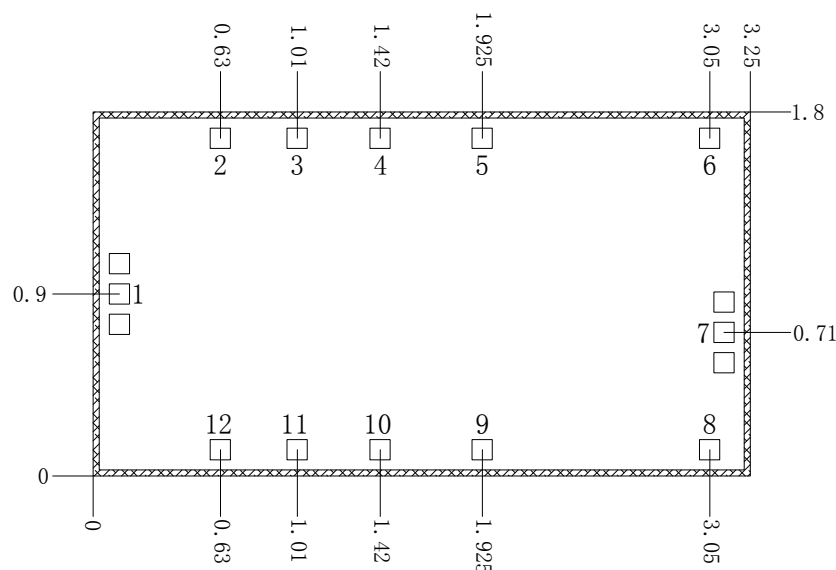
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+6.0V Zin=Zout=50Ω	32		36	GHz	
增益	G		20	23		dB	
输出功率	Psat		30	33		dBm	
输入驻波	VSWRi			1.5	3		
输出驻波	VSWRo			1.5	3		
输出 P-1	P-1		30	32		dBm	
电压	VD	VD=+6.0V	5.75	6	6.25	V	
电流	ID			1000	1200	mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+6.5	V	最大输入功率	+5	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

芯片尺寸图:

单位: mm

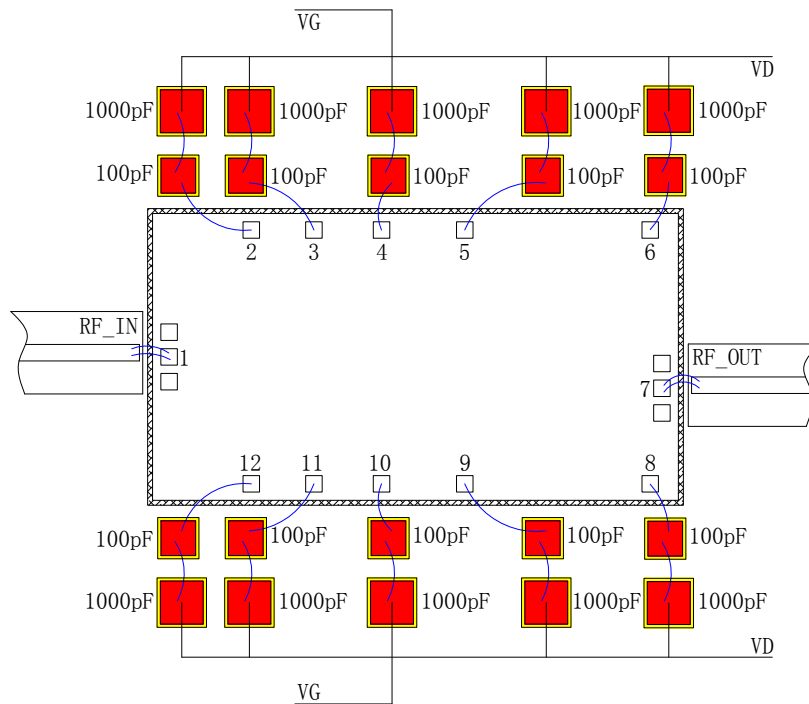


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

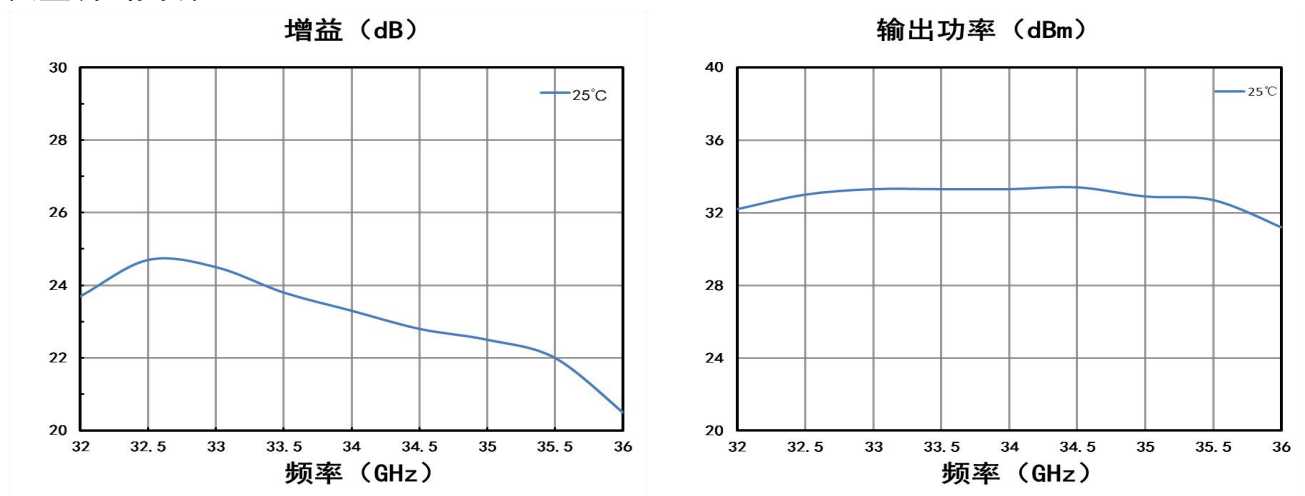
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
4, 10	VG	放大器栅极电压，需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12	VD	放大器电源电压，需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
7	OUT	射频输出，AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：

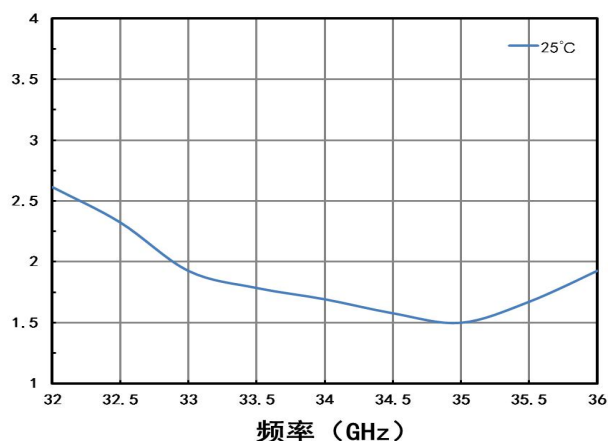


注：未标注的键合焊盘不需要连接

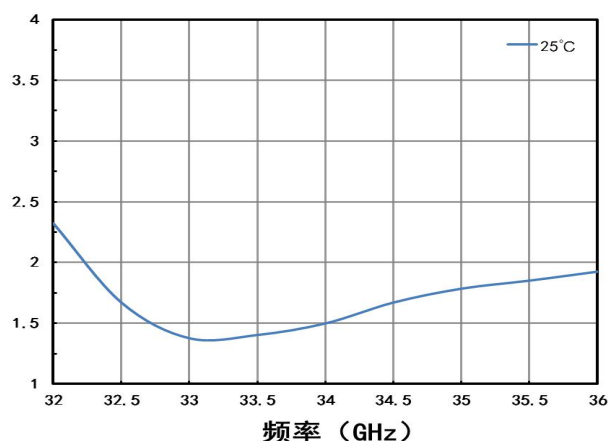
典型测试曲线：



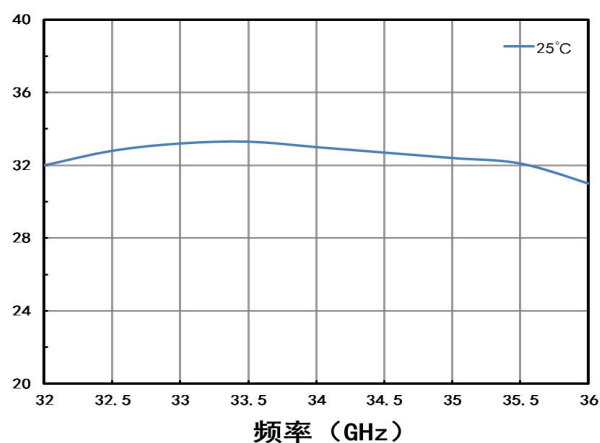
输入驻波比



输出驻波比



输出P-1dB (dBm)



产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。